

平成 29 年 4 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
代表者名 代表取締役社長 山村 章
(JASDAQ・コード6890)
問合せ先 取締役経営企画担当 若木 啓男
(03-3281-8186)

当社子会社における新会社設立並びに新工場稼働に関するお知らせ

当社は、昨年 11 月に当社子会社の上海申和熱磁電子有限公司の 100%連結子会社として、半導体製造装置、FPD 製造装置の部品の精密再生洗浄工場の新規開設を目的に、中華人民共和国遼寧省大連市に新会社（富樂徳科技發展（大連）有限公司）を設立し、開設準備を進めまいりましたが、このたび新工場が正式に稼働致しましたのでお知らせいたします。

1. 新会社設立並びに新工場を開設した狙い

当社は 2001 年に中国上海において、半導体製造装置、FPD 製造装置の部品の精密再生洗浄事業に参入して以来、天津、四川へと順調に拠点を拡大して参りました。また、最近『中国製造 2025[®]』に伴う中国政府による中国国内の半導体メーカー育成・強化の中で、微細化、3D 化等の先端投資に応じて半導体製造装置の部品の洗浄頻度と要求精度が日増しに上昇しており、当社の顧客である大手半導体デバイスメーカー及び FPD パネルメーカー並びに同製造装置メーカー各社から当社に対し、洗浄工場の新設要請が来ておりました。

当社としては顧客との関係強化と洗浄事業の更なる拡大を図れる好機と捉え、近年半導体メーカーの進出が著しい大連市に 4 拠点目の洗浄工場を新設しました。今回の工場新設により、当社は当該事業の中国における更なる市場シェアの拡大と収益力を向上させることが可能になるとともに、大手半導体デバイスメーカー及び FPD パネルメーカー並びに同製造装置メーカー各社の中国主要拠点における洗浄サポート体制の基盤強化が期待されます。

当社グループとしては、本精密再生洗浄事業を主力事業として育成していくとともに、その横展開として、主力セグメントである装置関連事業の半導体製造装置部品（マテリアル製品）の拡販に繋げ同事業の比重を上げていく所存です。

注) 中国政府（國務院）が、「製造強国」を目指すべく、2015 年 5 月 19 日に発表した将来における製造業発展のロードマップであり、2025 年に向けて中国の製造力を世界トップ水準に引き上げる発展方針が打ち出されております。その中には、製造業のイノベーション能力の向上や情報化と工業化の高度な融合の推進をはじめとする九つの戦略任務と、次世代情報技術、高度なデジタル制御の工作機械とロボット、航空・宇宙設備などからなる十の重点分野が盛り込まれており、半導体については、先端 IC とコア製造装置の国産化が主な方針として打ち出されています。

2. 設立した会社の概要

(1) 名 称	富楽徳科技發展（大連）有限公司	
(2) 所 在 地	中国遼寧省大連市大連保稅区大連環普國際產業園区内	
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 賀 賢漢	
(4) 事 業 内 容	半導体高純度アウトソース・プロセスツールパーツ洗浄サービス	
(5) 資 本 金	2,000 万人民元	
(6) 設 立 年 月 日	2016 年 12 月 28 日	
(7) 大株主及び持ち株比率	上海申和熱磁電子有限公司（当社連結子会社）100%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社が100%出資している上海申和熱磁電子有限公司が100%出資の孫会社となります。
	人 的 関 係	該当事項はありません
	取 引 関 係	記載すべき取引関係はありません。

3. 新工場の概要

(1) 所 在 地	中国遼寧省大連市大連保稅区大連環普國際產業園区内
(2) 工 場 契 約 面 積	約 6,395.52 m ²
(3) 進出地域、優遇措置	大連環普國際產業園区は大連保稅区の中心にあり、丹大高速道路の得勝出口から約 1km、新幹線大連北駅から約 42km に位置。排水・排気に関し、優遇措置あり。
(4) 投 資 形 態	土地、建物は賃貸。設備、造作物は自己投資による。
(5) 生 産 品 目	PVD, CVD, エッチング等 [®] で使用される半導体製造装置部品の高精密再生洗浄
(6) 投 資 金 額	約 2,000 万元（工場建物改造費用、設備投資、運転資金を含む）
(7) 稼働開始日	2017 年 3 月 28 日

4. 今後の見通し

当社の平成 30 年 3 月期の連結業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上

注) PVD (Physical Vapor Deposition): 物理的気相成長と言われる半導体製造プロセスの一つで、真空中で金属の原子や分子を物質の表面に高速でぶつけることでウェハーに膜を堆積させる方法。

CVD (Chemical Vapor Deposition): 化学的気相成長と言われる半導体製造プロセスの一つで、物質表面あるいは気相での化学反応によりウェハーの表面に膜を堆積させる方法。

エッチング: 半導体製造プロセスの一つで、ウェハー上に酸化膜等の薄膜を形成し、フォトリジストを塗布してパターン露光後に不要な薄膜を除去する方法。

【新工場の外観】



【竣工セレモニーの様子】

